



## МАЛОГАБАРИТНАЯ УСТАНОВКА ГАЗОФАЗНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ

# ЭПИ ЕТМ-М

### Назначение:

Осаждение эпитаксиальных слоев на монокристаллические подложки кремния или сапфира.

### Особенности:

- Кварцевый реактор с «холодной» стенкой;
- Полуавтоматическая перегрузка пластин с применением линейного манипулятора;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 32 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой ~ 7 м<sup>2</sup>.

